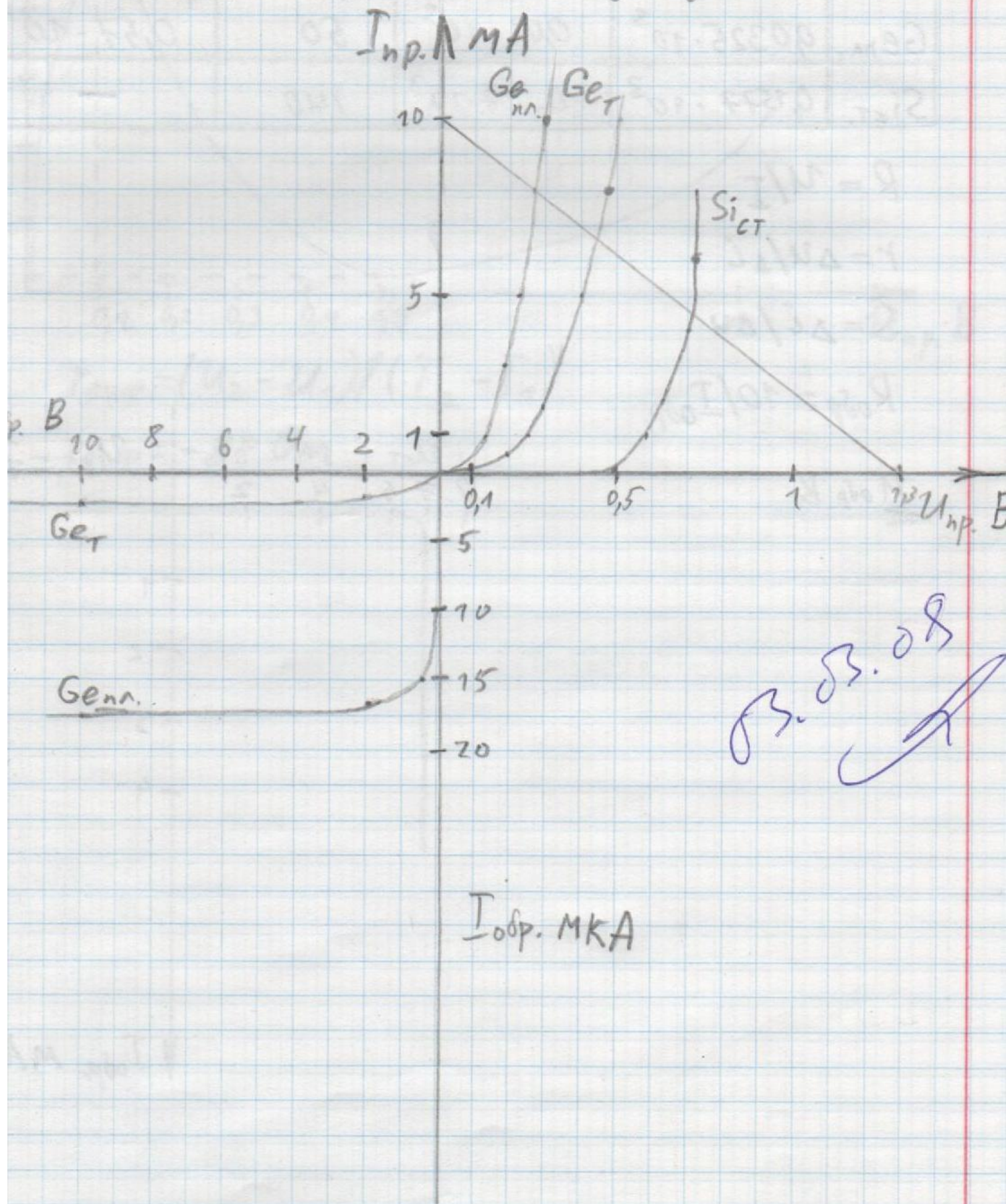


# Лабораторная работа

## исследование вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов





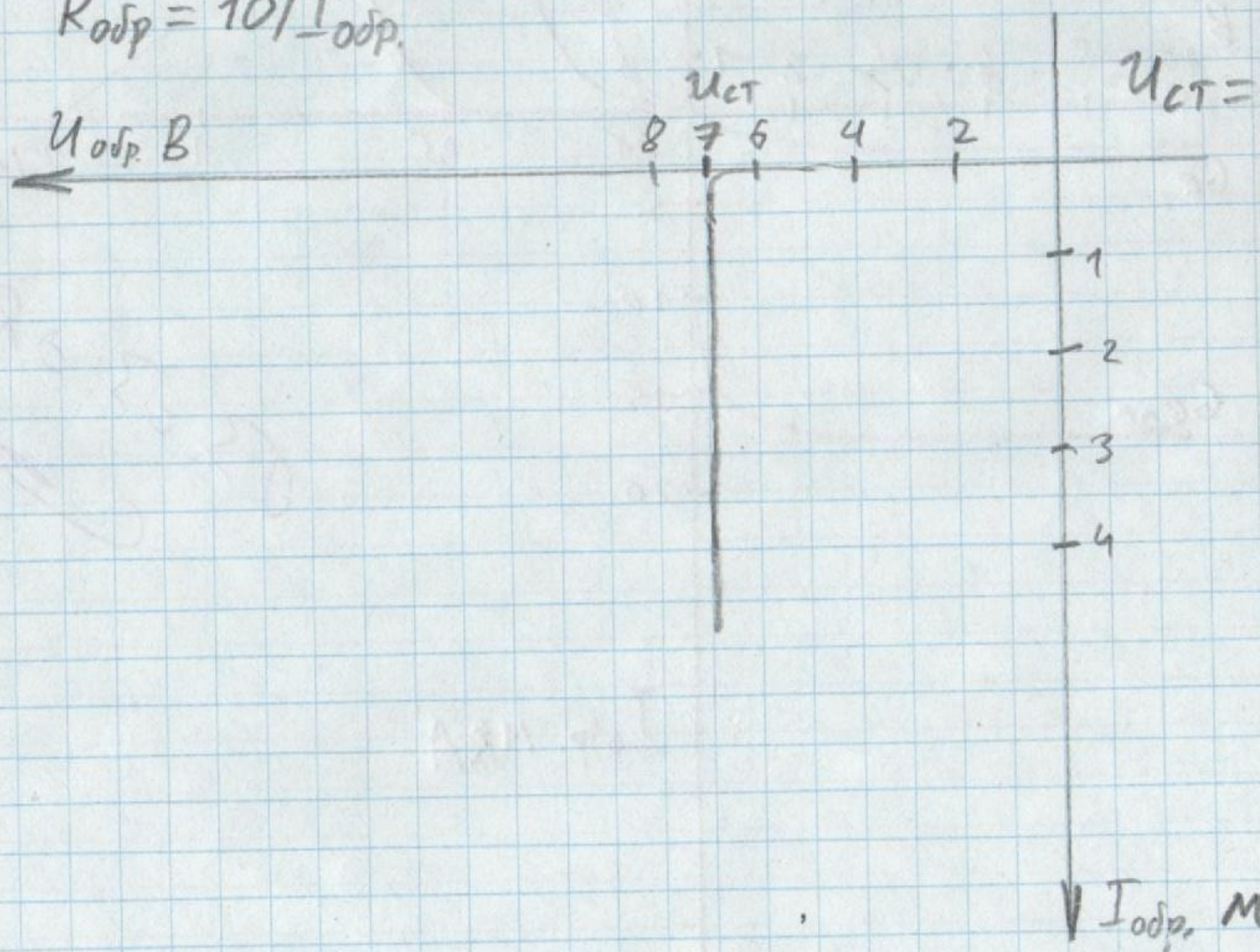
	$R (\Omega m)$	$r (\Omega m)$	$S (mA/B)$	$R_{odp.} (\Omega m)$
$Ge_T$	$0,0651 \cdot 10^3$	$0,03 \cdot 10^3$	29,25	$4 \cdot 10^6$
$Ge_{na.}$	$0,0325 \cdot 10^3$	$0,02 \cdot 10^3$	50	$0,57 \cdot 10^6$
$Si_{CT.}$	$0,1577 \cdot 10^3$	$0,007 \cdot 10^3$	140	—

$$R = U/I$$

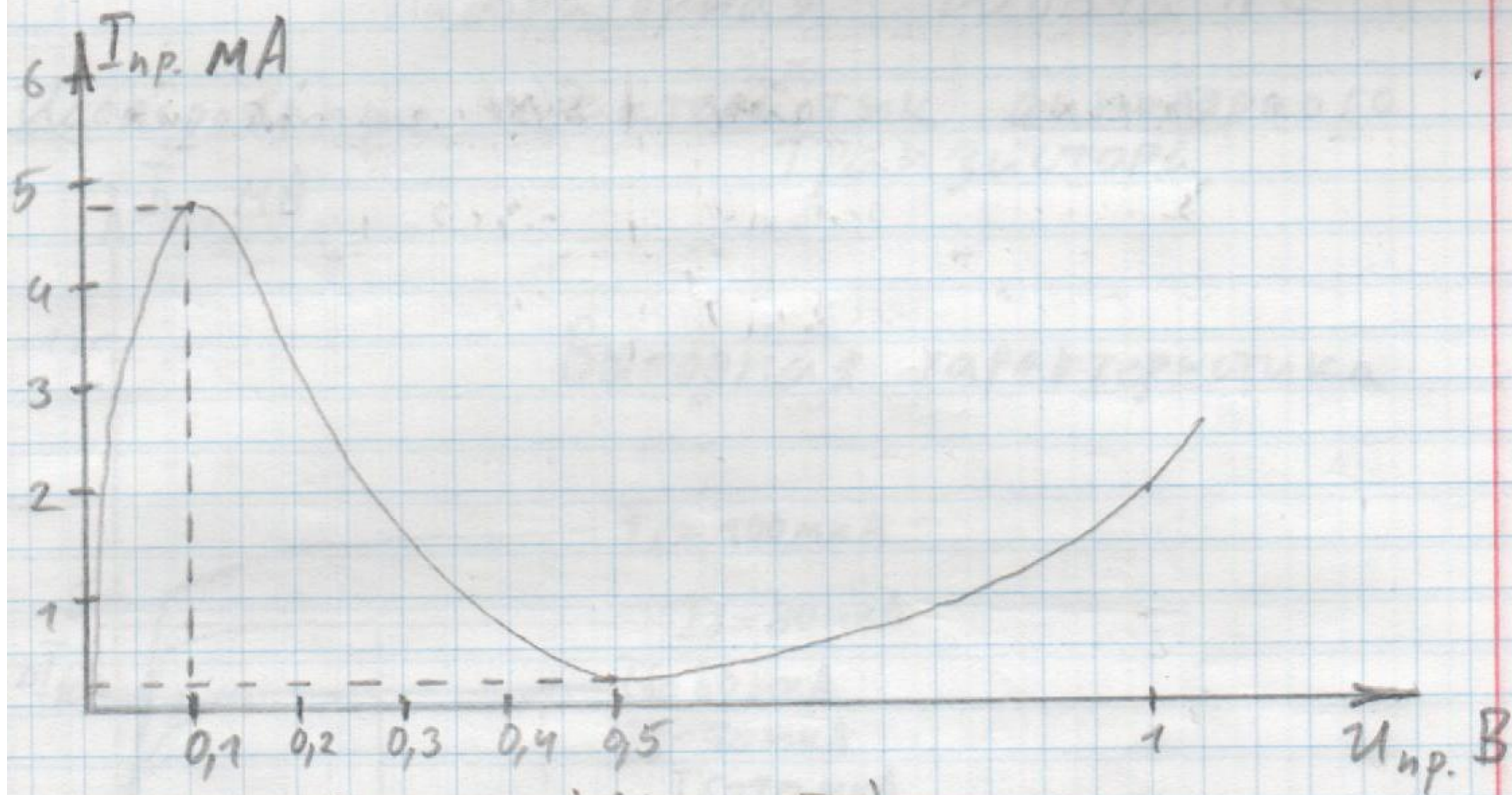
$$r = \Delta U / \Delta i$$

$$S = \Delta i / \Delta U$$

$$R_{odp.} = 10 / I_{odp.}$$







$$r_{qup} = (U_2 - U_1) / (I_2 - I_1)$$

$$r_{qup} = -880 \Omega$$